世界知的所有権機関
国際事務局

PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類6 H01L 21/60	A1	(11) 国際公開番号	WO00/02245
		(43) 国際公開日	2000年1月13日(13.01.00)

(21) 国際出願番号 PCT/JP99/03420

(22) 国際出願日 1999年6月25日(25.06.99)

(30) 優先権データ
特願平10/201246 1998年7月1日(01.07.98) JP

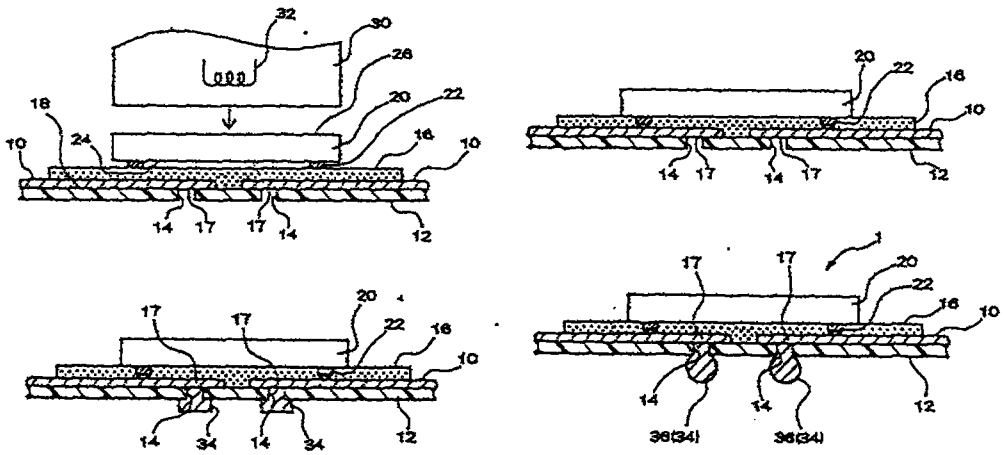
(81) 指定国 CN, JP, KR, SG, US

添付公開書類
国際調査報告書

(71) 出願人（米国を除くすべての指定国について）
セイコーエプソン株式会社
(SEIKO EPSON CORPORATION)[JP/JP]
〒163-0811 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 Tokyo, (JP)
(72) 発明者；および
(75) 発明者／出願人（米国についてのみ）
橋元伸晃(HASHIMOTO, Nobuaki)[JP/JP]
〒392-8502 長野県諏訪市大和3丁目3番5号
セイコーエプソン株式会社内 Nagano, (JP)
(74) 代理人
井上 一, 外(INOUE, Hajime et al.)
〒167-0051 東京都杉並区荻窪5丁目26番13号
荻窪TMビル2階 Tokyo, (JP)

(54)Title: SEMICONDUCTOR DEVICE, METHOD OF MANUFACTURE THEREOF, CIRCUIT BOARD, AND ELECTRONIC DEVICE

(54)発明の名称 半導体装置及びその製造方法、回路基板並びに電子機器



(57) Abstract

A method of manufacturing a semiconductor device comprises a first step of interposing a thermosetting anisotropic conductive material (16) between a substrate (12) and a semiconductor element (20); a second step of applying pressure and heat between the semiconductor element (20) and the substrate (12) to force the anisotropic conductive material (16) to extend beyond the edges of the semiconductor element (20), and hardening the anisotropic conductive material (16) in the region where it is in contact with the semiconductor element (20); and a third step of heating the anisotropic conductive material (16) in the regions where it is not in contact with the semiconductor element (20).